Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FP50R06KE3

power electronics in motion
eupec

EconoPIM™2 Modul mit Trench/Feldstop IGBT³ und EmCon3 Diode
EconoPIM™2 module with the trench/fieldstop IGBT³ and EmCon3 diode

IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

Vorläufige Daten / preliminary data

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 80°C, T_{vj} = 175°C T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	$I_{C\ nom}$ I_C	50 60	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	P_{tot}	190	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$V_{CE\ sat}$	1,45 1,60 1,70	1,90	V V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,9	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V, V_{CE} = 300V		Q_G		0,50		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		3,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		0,095		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 600 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ on}$		0,10 0,10 0,10		µs µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_r		0,06 0,065 0,07		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ off}$		0,60 0,65 0,70		µs µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_f		0,04 0,05 0,06		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 25 nH V_{GE} = ±15 V, di/dt = 900 A/µs (T_{vj}=150°C) R_{Gon} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{on}		2,30 2,75 2,90		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 25 nH V_{GE} = ±15 V, du/dt = 2500 V/µs (T_{vj}=150°C) R_{Goff} = 43 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,75 2,10 2,15		mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj} = 25°C t_P ≤ 6 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		350 250		A A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT		R_{thJC}			0,80	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,335		K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Wechselrichter / diode-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C		V_{RRM}	600	V
Dauergleichstrom DC forward current			I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_P = 1 ms		I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C		I²t	330 300	A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_F		1,55 1,50 1,45	1,95	V V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 50 A, - di_F/dt = 900 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		27,0 34,0 36,0		A A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 50 A, - di_F/dt = 900 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		1,25 2,85 3,55		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 50 A, - di_F/dt = 900 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,20 0,50 0,60		mJ mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode		R_{thJC}			1,20	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,50		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Gleichrichter / diode-rectifier

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	T_C = 80°C	I_{FRMSM}	70	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	T_C = 80°C	I_{RMSM}	50	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I_{FSM}	450 370	A A
Grenzlastintegral I²t - value	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t	1000 685	A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	T_{vj} = 150°C, I_F = 50 A	V_F		1,05		V
Sperrstrom reverse current	T_{vj} = 150°C, V_R = 1600 V	I_R		1,00		mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			0,85	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,355		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 65°C, T_{vj} = 175°C T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	I_{Cnom} I_C	30 37	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	60	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	P_{tot}	125	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V I_C = 30 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$V_{CE\ sat}$	1,55 1,70 1,80	2,00	V V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 0,43 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,9	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		0,30		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		0,00		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		1,65		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		0,051		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 600 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ on}$		0,10 0,10 0,10		µs µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_r		0,06 0,065 0,07		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ off}$		0,60 0,65 0,70		µs µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_f		0,04 0,045 0,05		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{on}		1,40 1,70 1,80		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 30 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 56 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,00 1,15 1,20		mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} · di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj} = 25°C t_P ≤ 6 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		210 150		A A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT		R_{thJC}			1,20	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,50		K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	600		V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	20		A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t_p = 1 ms	I_{FRM}	40		A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t	45,0 45,0		A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_F		1,60 1,55 1,50	2,00	V V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 20 A, - di_F/dt = 2500 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		36,0 38,0 42,0		A A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 20 A, - di_F/dt = 2500 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		1,00 1,70 2,20		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 20 A, - di_F/dt = 2500 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,25 0,40 0,55		mJ mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode		R_{thJC}			2,30	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,96		K/W

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	T_C = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	T_C = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	T_C = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298{,}15\ K))]$	$B_{25/50}$		3375		K

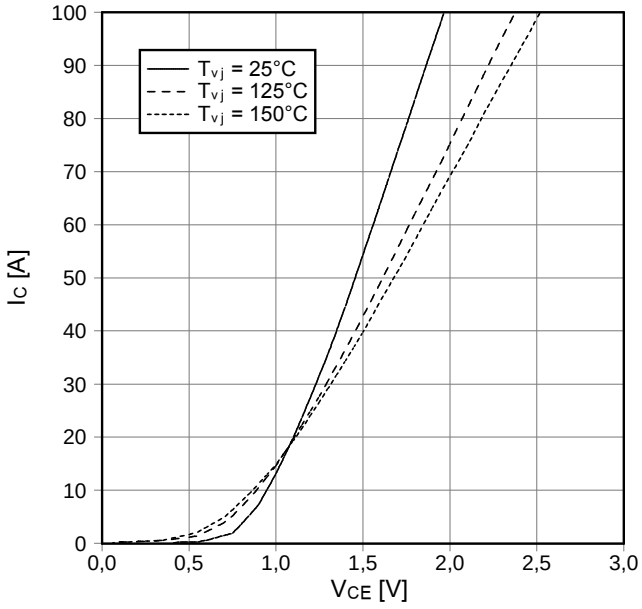
Vorläufige Daten
preliminary data

Modul / module

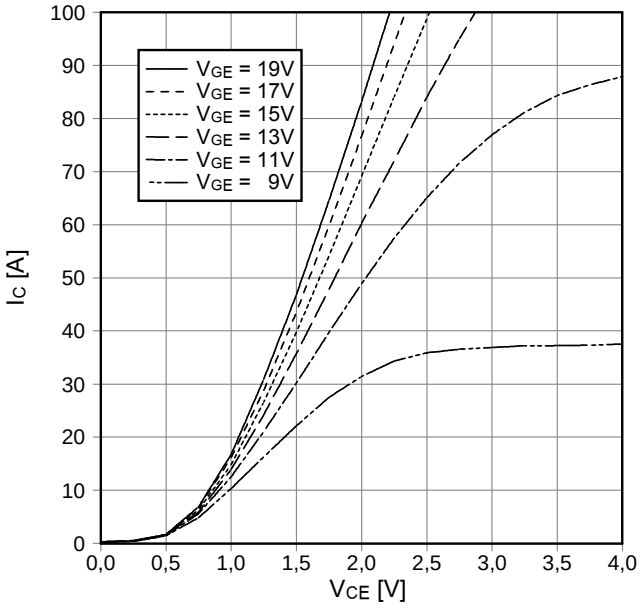
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
Material Modulgrundplatte material of module baseplate				Cu		
Material für innere Isolation material for internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI		> 225		
			min.	typ.	max.	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,02		K/W
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}		60		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$ $R_{AA'+CC'}$		4,00 3,00		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper Gleichrichter / rectifier	$T_{vj\ max}$			175 150	°C °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper Gleichrichter / rectifier	$T_{vj\ op}$	-40 -40		150 150	°C °C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M5 - mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00	Nm
Gewicht weight		G		180		g

Vorläufige Daten
preliminary data

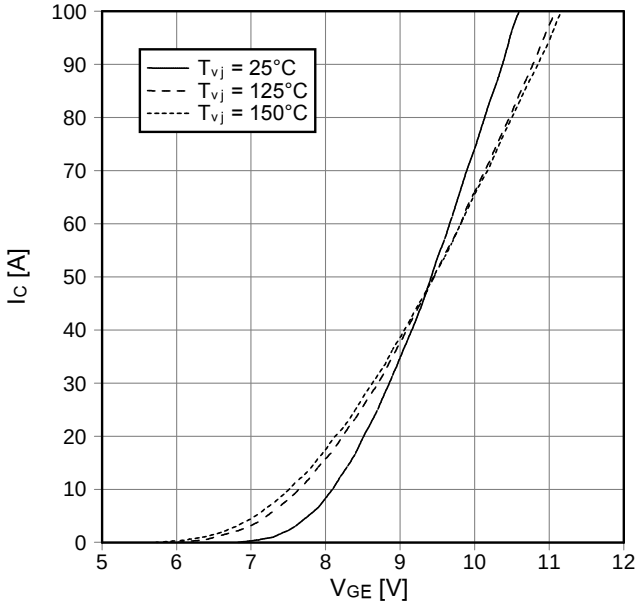
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



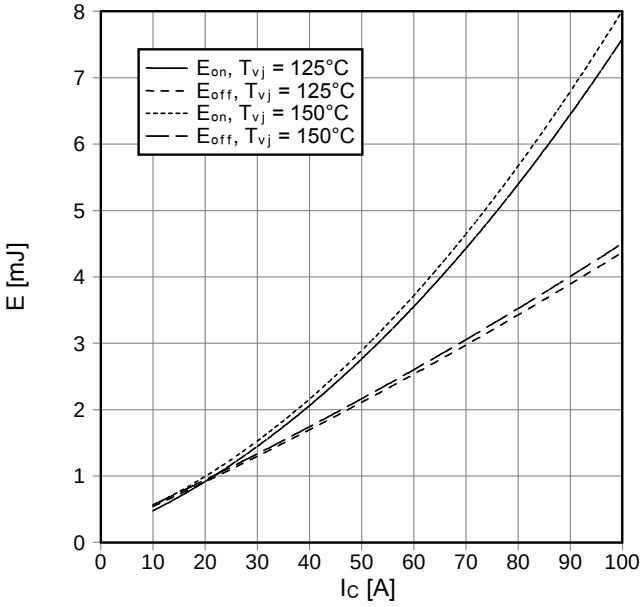
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150°C



Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



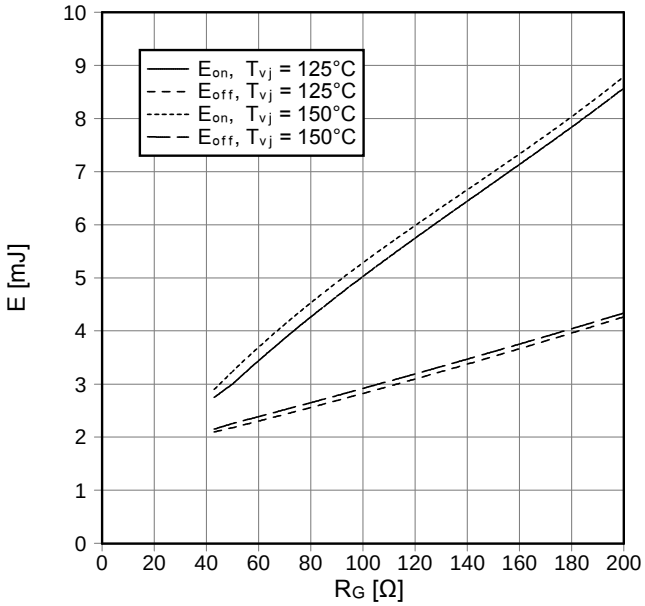
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 43 Ω, R_{Goff} = 43 Ω, V_{CE} = 300 V



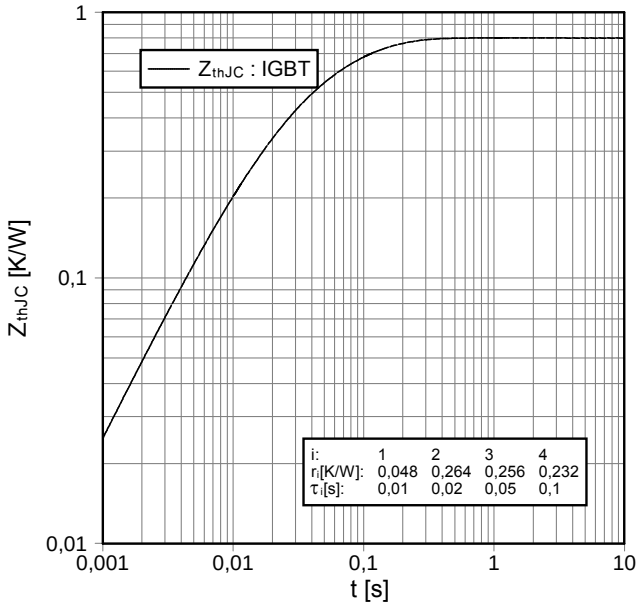
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

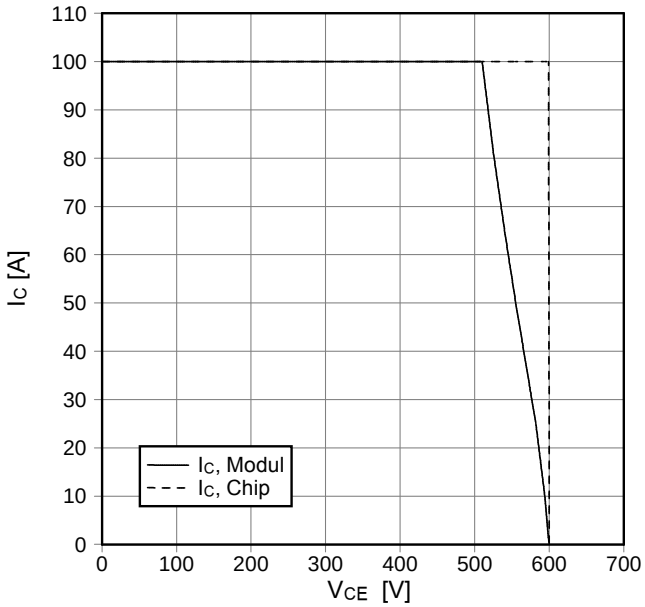
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V



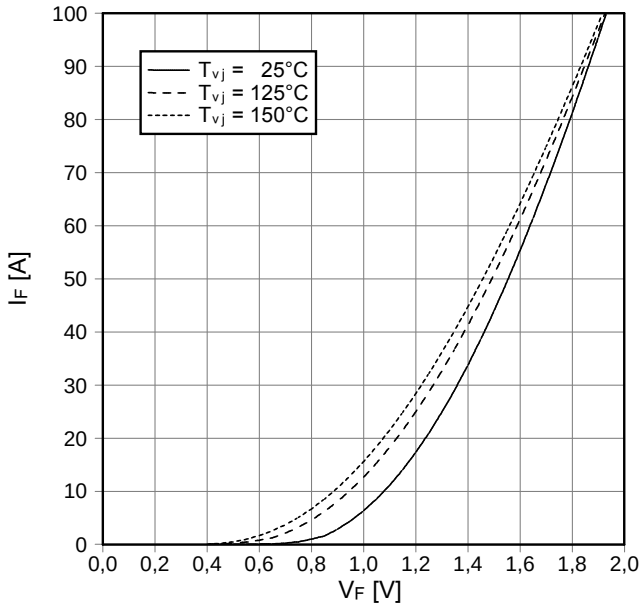
Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter
$Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 43 Ω, T_{vj} = 150°C



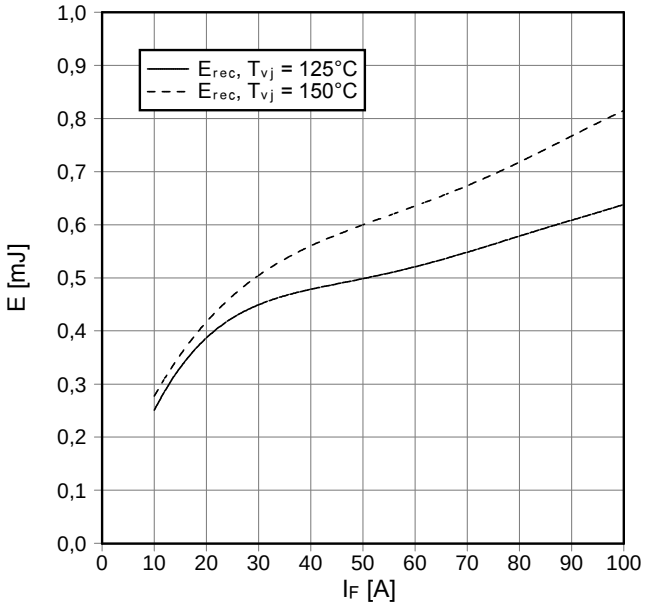
Durchlasskennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



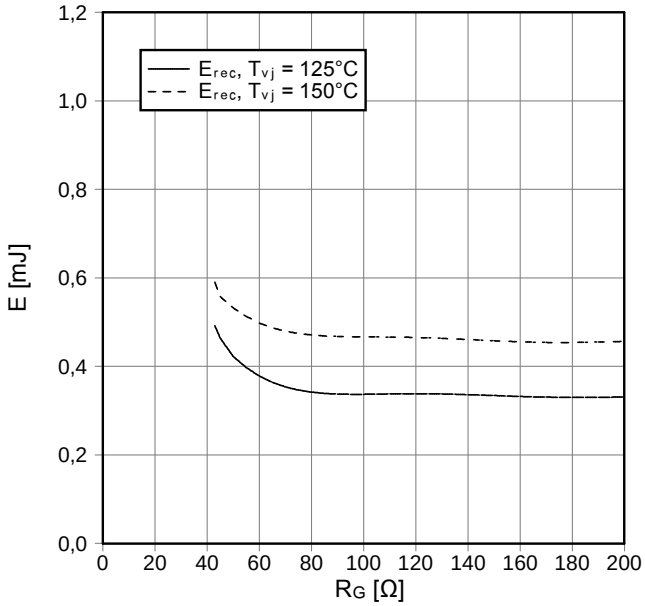
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

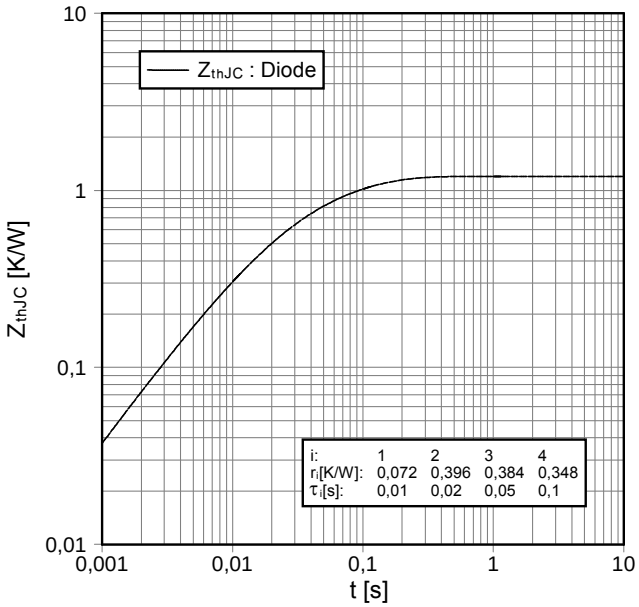
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 43\ \Omega$, $V_{CE} = 300$ V



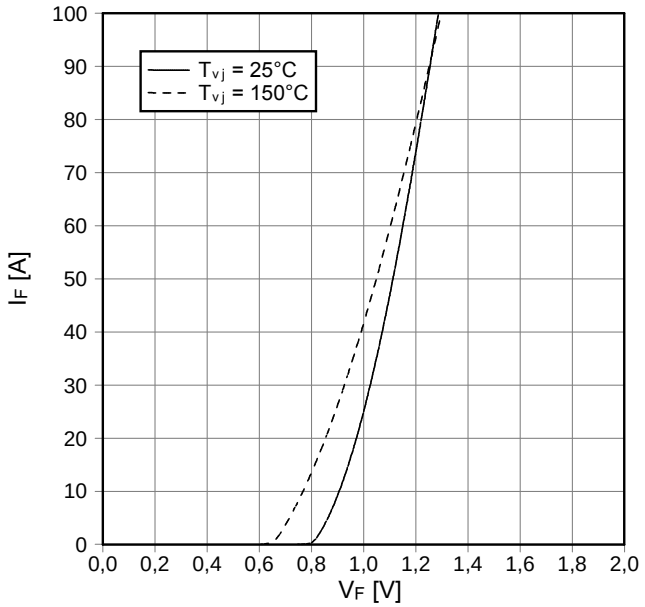
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 50$ A, $V_{CE} = 300$ V



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter
$Z_{thJC} = f(t)$



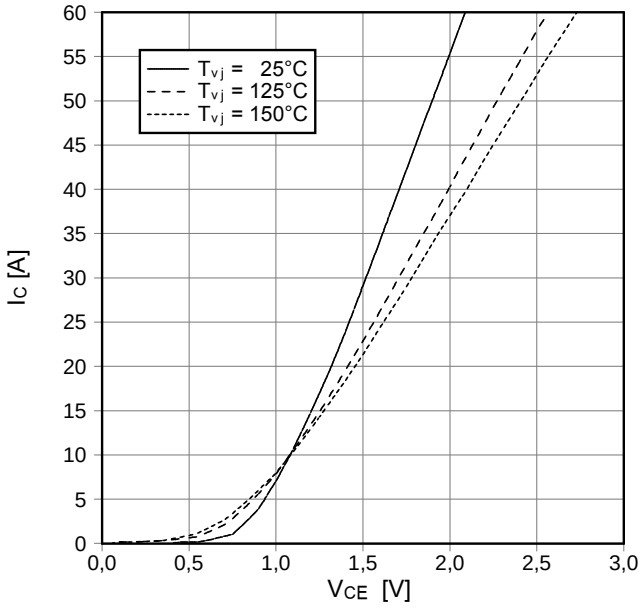
Durchlasskennlinie der Diode-Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of diode-rectifier (typical)
$I_F = f(V_F)$



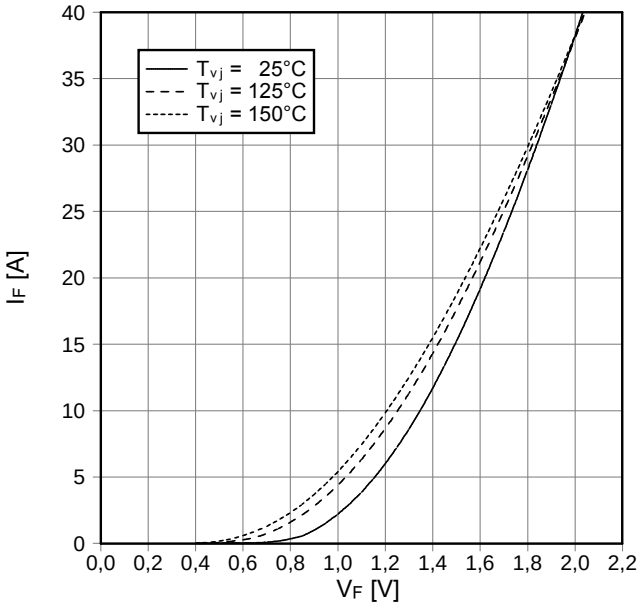
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

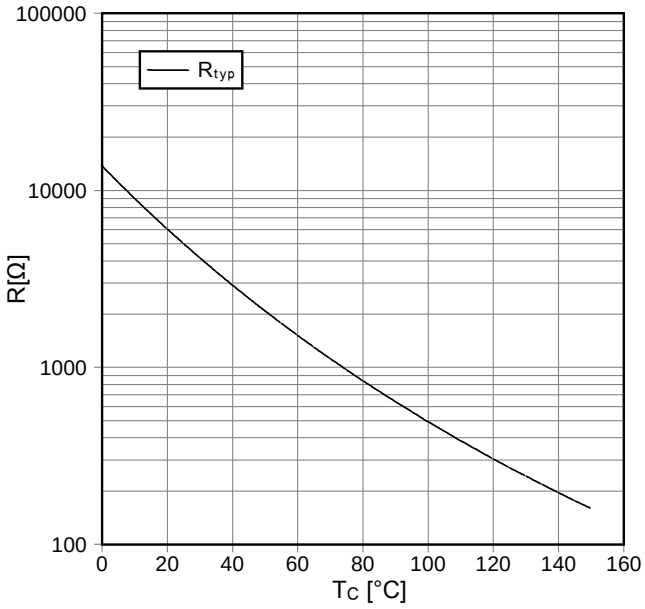
Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Copper (typisch)
output characteristic IGBT-brake-chopper (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



Durchlasskennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of diode-brake-chopper (typical)
$I_F = f(V_F)$



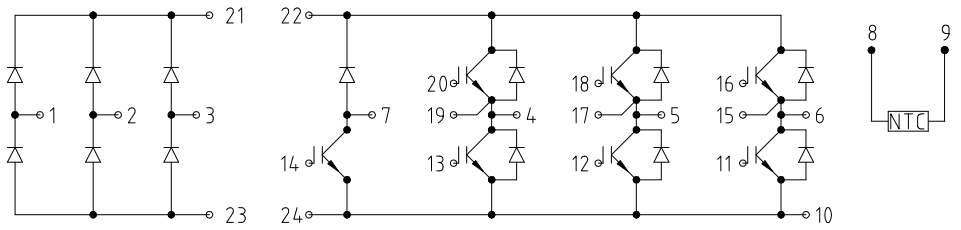
NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)
R = f (T)



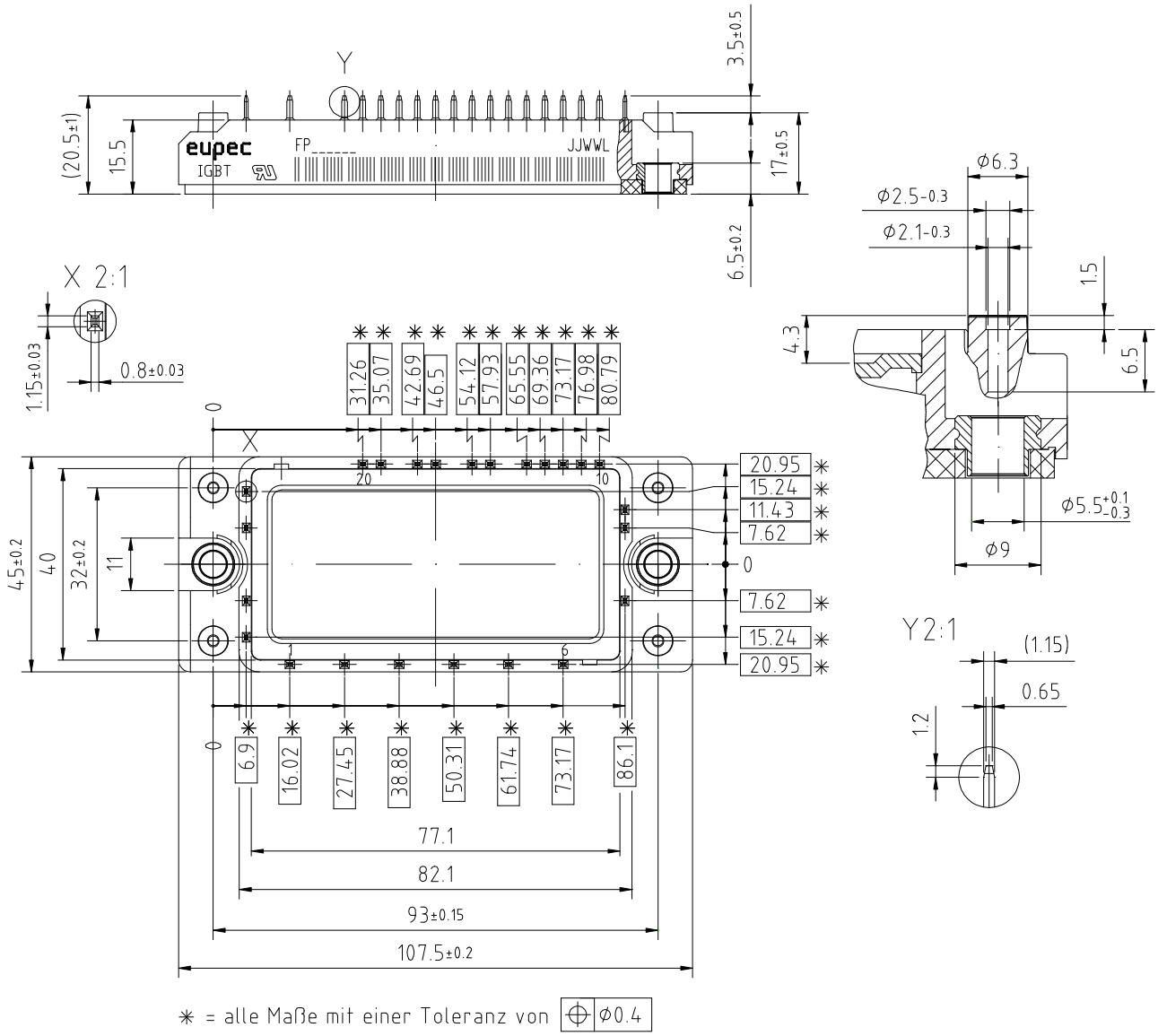
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



✳ = alle Maße mit einer Toleranz von ⌖ ϕ0.4

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-2-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

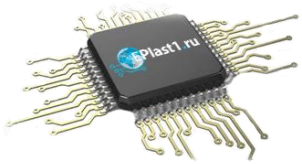
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.